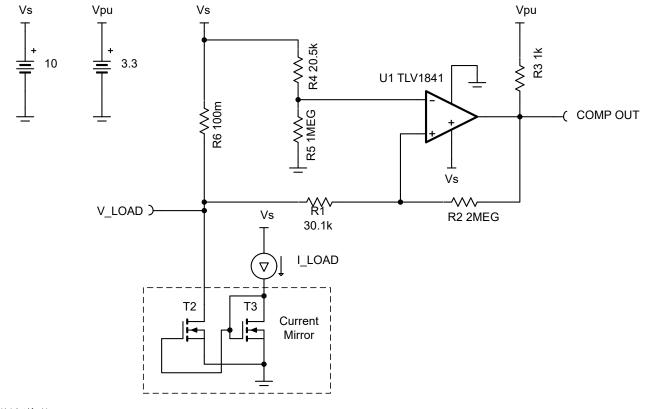


#### 设计目标

负载电流(I <sub>L</sub> )		系统电源 (V <sub>S</sub> )	比较器输出状态	
过流 (I <sub>OC</sub> )	恢复电流(I <sub>RC</sub> )	典型值	过流	正常运行
1A	0.5A	10V	V <sub>OL</sub> < 0.4V	$V_{OH} = V_{PU} = 3.3V$

#### 设计说明

该高侧电流检测电路使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施迟滞以确保在负载电流减小至 0.5A (减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用开漏输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。



#### 设计说明

- 1. 选择具有轨到轨输入共模范围的比较器,以实现高侧电流检测。
- 2. 选择具有漏极开路输出级的比较器,以进行电平转换。
- 3. 选择具有低输入失调电压的比较器,以优化精度。
- 4. 计算分流电阻器  $(R_6)$  的值,使分流电压  $(V_{SHUNT})$  至少比比较器失调电压  $(V_{IO})$  大 10 倍。



#### 设计步骤

1. 选择  $R_6$  的值,使  $V_{SHUNT}$  至少比比较器输入失调电压  $(V_{IO})$  大 10 倍。如果使用非常大的  $R_6$  值,会提高 OC 检测精度,但会降低电源余量。

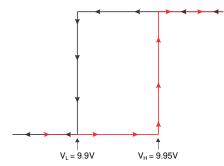
$$V_{SHUNT} = (I_{OC} \times R_6) \ge 10 \times V_{IO} = 55 \text{mV}$$

set 
$$R_6 = 100 m\Omega$$
 for  $I_{OC} = 1A$  and  $V_{IO} = 5.5 mV$ 

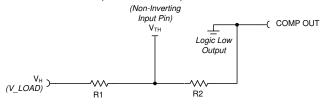
2. 确定当比较器输出从高电平转换为低电平  $(V_L)$  和从低电平转换为高电平  $(V_H)$  时所需的开关阈值。 $V_L$  表示负载电流超过 OC 电平的阈值,而  $V_H$  表示负载电流恢复至的正常工作电平的阈值。

$$V_L = V_S - (I_{OC} \times R_6) = 10 - (1 \times 0.1) = 9.9V$$

$$V_H = V_S - (I_{RC} \times R_6) = 10 - (0.5 \times 0.1) = 9.95V$$

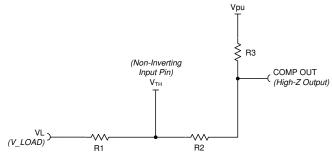


3. 在将比较器的非反相输入引脚标记为  $V_{TH}$  且比较器输出处于逻辑低电平状态(接地)的情况下,推导出  $V_{TH}$  的计算公式,其中  $V_{H}$  表示当比较器输出从低电平转换为高电平时的负载电压( $V_{LOAD}$ )。请注意,用于推导出该公式的简化图显示比较器输出为接地(逻辑低电平)。



$$V_{TH} = V_H \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

4. 在将比较器的非反相输入引脚标记为 $V_{TH}$ 且比较器输出处于高阻抗状态的情况下,推导出 $V_{TH}$ 的计算公式,其中 $V_L$ 表示当比较器输出从高电平转换为低电平时的负载电压 $(V_{LOAD})$ 。建议应用*叠加*原理来求解 $V_{TH}$ 。



$$\textbf{V}_{TH} = \textbf{V}_L \times \left(\frac{\textbf{R}_2 + \textbf{R}_3}{\textbf{R}_1 + \textbf{R}_2 + \textbf{R}_3}\right) + \textbf{V}_{PU} \times \left(\frac{\textbf{R}_1}{\textbf{R}_1 + \textbf{R}_2 + \textbf{R}_3}\right)$$

5. 通过将两个方程设置为彼此相等来消除变量  $V_{TH}$  并求解  $R_1$ 。结果为以下二次方程。对  $R_2$  的求解是不太理想的,因为小电阻器值的标准值比大电阻器值更多。

$$0 = (V_{PU}) \times R_1^2 + (V_{PU} \times R_2 + V_L \times (R_3 + R_2) - V_H \times R_2) \times R_1 + (V_L - V_H) \times (R_2^2 + R_2 \times R_3)$$

6. 选择 R3 和 R2 的值。R<sub>3</sub> 远小于 R<sub>2</sub> (R<sub>3</sub> << R<sub>2</sub>)。由于增大 R<sub>3</sub> 会导致比较器逻辑高输出电平增加到超过  $V_{PU}$ ,因此应避免增大 R<sub>3</sub>。例如,将 R<sub>3</sub> 增大到 100kΩ 的值可能会导致逻辑高输出电平为 3.6V。在本例中,选择 R<sub>2</sub> = 2M 且 R<sub>3</sub> = 1k Ω。

$$R_2 \, = \, 2 M \Omega$$

$$R_3 = 1k\Omega$$

7. 在对  $V_{PU}$ 、 $R_2$ 、 $V_L$ 、 $V_H$  和  $R_3$  代入数值之后,计算  $R_1$ 。对于该设计,设置  $V_{PU}$  = 3.3、 $R_2$  = 2M、 $V_L$  = 9.9、 $V_H$  = 9.95 以及  $R_3$  = 1k $\Omega$ 。

$$0 = (3.3) \times R_1^2 + (6.591M) \times R_1 - (200.1G)$$

the positive root for  $R_1=29.9 \mathrm{k}\Omega$ 

using standard 1 % resistor values,  $\,R_1=30\,.\,1k\Omega$ 

8. 使用 *设计步骤* 3 中导出的公式计算  $V_{TH}$  ; 使用计算出的  $R_1$  值。请注意, $V_{TH}$  小于  $V_L$ ,因为  $V_{PU}$  小于  $V_L$ 。

$$V_{TH} = V_H \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = 9.802V$$

9. 在反相端子标记为  $V_{TH}$  的情况下,导出根据  $R_4$ 、 $R_5$  和  $V_S$  计算  $V_{TH}$  的公式。

$$V_{TH} = V_S \times \left(\frac{R_5}{R_4 + R_5}\right)$$

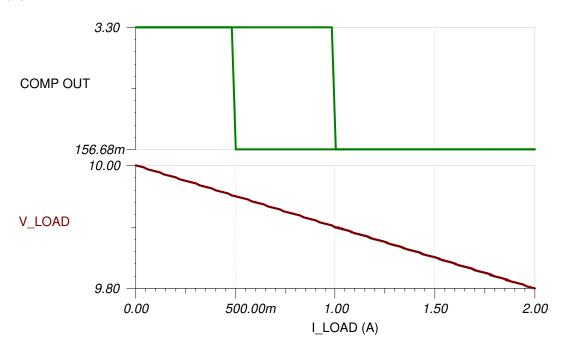
10. 在代入数值  $R_5$  = 1M、 $V_S$  = 10 及计算出的  $V_{TH}$  值之后,计算  $R_4$ 。

$$R_4 = \left(\frac{R_5 \times (V_S - V_{TH})}{V_{TH}}\right) = 20.15 \text{k}\Omega$$

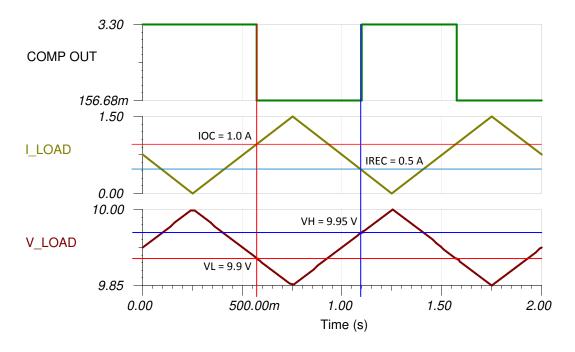
using standard 1 % resistor values,  $\,R_4=20\,.\,5k\Omega$ 



# 设计仿真 直流仿真结果



## 瞬态仿真结果



www.ti.com.cn *商标* 

#### 设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅 模拟工程师电路手册。

请参阅电路 SPICE 仿真文件 SLOM456。

## 设计特色比较器

参数	TLV184x	TLV183x
Vs	2.7V 至 40V	2.7V 至 40V
V <sub>inCM</sub>	2.7V 至 40V	2.7V 至 40V
V <sub>OUT</sub>	开漏	推挽
V <sub>os</sub>	500µV	500µV
IQ	70µA/通道	70µA/通道
t <sub>PD(HL)</sub>	65ns	65ns
通道数	1、2、4	1、2、4
	TLV184x	TLV183x

#### 设计备用比较器

	TLV902x_3x	TLV323x
Vs	1.6V 至 5.5V	2.7V 至 5.5V
V <sub>inCM</sub>	轨到轨	轨到轨
V <sub>OUT</sub>	开漏、推挽	推挽
Vos	300µV	500μV
ΙQ	16µA/通道	200µA/通道
t <sub>PD(HL)</sub>	100ns	20ns
通道数	1、2、4	1、2
	TLV902x_3x	TLV3231

## 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司